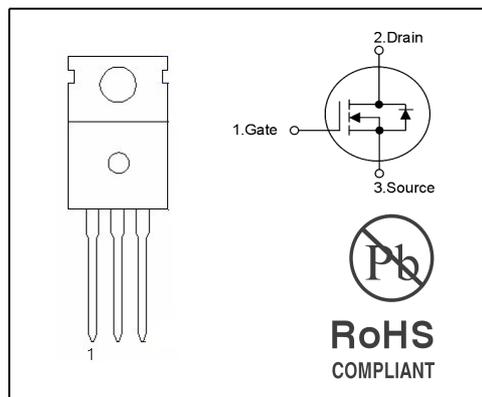


产品描述

FHP75N08为低压大电流功率MOS场效应管，广泛应用于电源逆变器

产品特点

- ★ 80A,75V, $R_{DS(on)}$ (典型值) 8.8m Ω
- ★ 开关速度快



极限值 (Tc=25°C)

参数名称	符号	数值	单位
漏极—源极电压	V_{DS}	75	V
漏极电流 @Tc=25°C	I_D	80	A
栅源电压	V_{GS}	± 25	V
耗散功率 @Tc=25°C	P_D	270	W
结温	T_J	150	°C
储存温度	T_{stg}	-55~150	°C

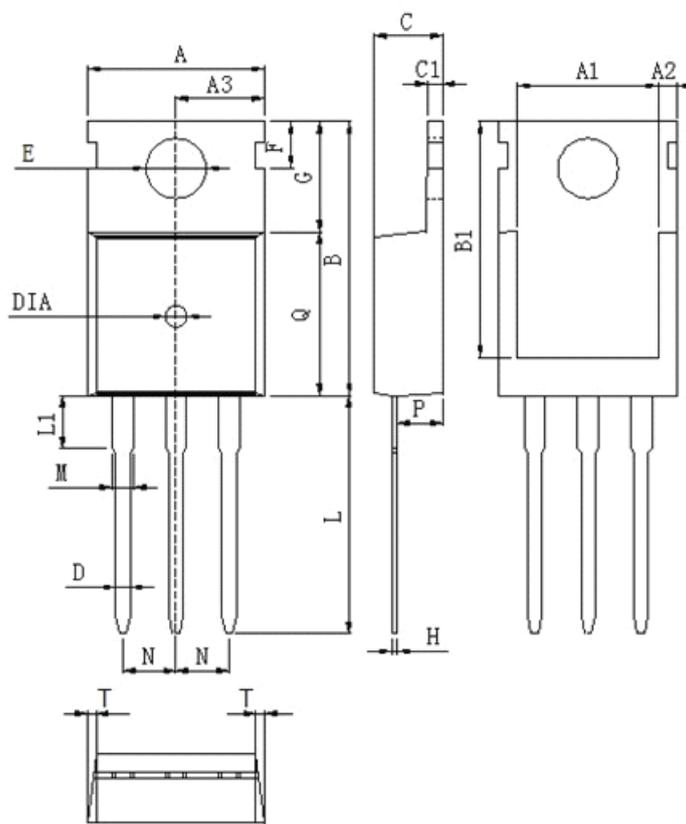
特性参数值 (Tc=25°C)

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源反向电压	B_{VDSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	75	---	---	V
漏源截止电流	I_{DSS}	$V_{DS}=75V, V_{GS}=0V$	---	---	1	μA
栅源截止电流	$I_{GSS(F/R)}$	$V_{GS} = \pm 25V, V_{DS}=0V$	---	---	± 100	nA
通态电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=40A$	---	8.8	11	m Ω
栅源极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$	2.0	---	4.0	V
源漏二极管正向导通压降	V_{FSD}	$I_S=20A, V_{GS}=0V$	---	---	1.4	V

封装外形

★ TO-220AB

★ 图形尺寸



标注	毫米
A	10.0±0.2
A1	8.0±0.2
A2	1.0±0.2
A3	5.0±0.2
B	15.8±0.2
B1	13.2±0.2
C	4.5±0.2
C1	1.3±0.2
D	0.8±0.2
E	3.6±0.2
F	3.0±0.2
G	6.6±0.2
H	0.5±0.2
L	13.0±0.2
L1	3.0±0.2
M	1.3±0.2
N	2.5±0.2
P	2.1±0.2
Q	9.1±0.2
T	0.259.1±0.1
DIA	宽 1.5±0.1 深 0.03±0.01